

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: Phó giáo sư
Mã hồ sơ:.....**



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng

Ngành: Điện tử; Chuyên ngành: Điện tử

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: Phạm Nguyễn Thanh Loan

2. Ngày tháng năm sinh: 01/02/1982; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): Tổ 64 Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): C9-401, Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, 01 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: +84983205761;

E-mail: loan.phamnguyenthanh@hust.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

Từ tháng, năm 09,2010 đến tháng, năm 08,2011: Tập sự tại Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 09,2011 đến tháng, năm 05,2016: Giảng viên tại Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 06,2016 đến tháng, năm 01,2022: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển điện tử viễn thông, Viện Điện tử- Viễn thông, tại Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 08,2016 đến tháng, năm 04,2019: Trợ lý đào tạo Đại học tại Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 04,2019 đến tháng, năm 01,2022: Phó trưởng bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính tại Bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính, Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 04,2022 đến tháng, năm 06,2023: Giám đốc chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT tại Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Từ tháng, năm 04,2022 đến tháng, năm 06,2023: Trưởng nhóm chuyên môn Vi điện tử và Mạch tích hợp tại Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Chức vụ hiện nay: Giám đốc chương trình đào tạo hệ thống nhúng thông minh và IOT; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó bộ môn Điện tử và Kỹ thuật máy tính; Phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển Điện tử Viễn thông, Viện Điện tử Viễn thông

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội

Địa chỉ cơ quan: C9-401, Khoa Điện tử, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 3869 6099

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): Đại học Bách khoa Hà Nội

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 02 tháng 11 năm 2005, số văn bằng: 02271/2023/KS, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Điện tử và hệ thống truyền thông

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Đại học Ecole Centrale de Lyon, Pháp

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 26 tháng 10 năm 2007, số văn bằng: 02272/2023/ThS, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Điện tử Micro và Nano

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Đại học Joseph Fourier, Pháp

- Được cấp bằng TS [5] ngày 12 tháng 07 năm 2010, số văn bằng: 02273/2023/TS, ngành: Điện tử, chuyên ngành: Điện tử Micro và Nano

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Đại học Institut Polytechnique de Grenoble, Pháp

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng I: Điện, Điện tử - Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Toán học

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-Tự động hóa

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

1. Nghiên cứu và thiết kế vi mạch tích hợp tương tự (IC tương tự) cho khối thu công suất thấp cho các ứng dụng IoT và y sinh.
2. Nghiên cứu và thiết kế vi mạch tích hợp tương tự (IC tương tự) cho mạch công suất hiệu suất cao.

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn (số lượng) 2 NCS bảo vệ thành công luận án TS;
- Đã hướng dẫn (số lượng) 12 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 1 cấp Nhà nước; 2 cấp Cơ sở;
- Đã công bố (số lượng) 52 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp (số lượng) 1 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 2, trong đó 2 thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế: 0

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

TT	Tên khen thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
Không có			

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định):

TT	Tên kỷ luật	Cấp ra quyết định	Số quyết định	Thời hạn hiệu lực
Không có				

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

- Mức độ hoàn thành khối lượng giảng dạy: Hoàn thành đầy đủ khối lượng được giao và vượt mức khối lượng quy định.

- Hoàn thành nhiệm vụ của giảng viên theo quy định hiện hành: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ của giảng viên căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật Giáo dục đại học 2012, điểm a,b,c và điểm d khoản 30 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018.

- Năng lực giảng dạy: Có đầy đủ các chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo yêu cầu của Bộ GDĐT; sử dụng các phương pháp giảng dạy linh hoạt, tích cực và phù hợp với trình độ của sinh viên; tham gia nhóm giảng dạy sử dụng phương pháp giảng dạy hỗn hợp (Blended-Learning).

- Ý kiến phản hồi của người học trong 3 năm gần nhất: giảng viên có trách nhiệm với bài giảng và sinh viên, tuân thủ các quy tắc về giờ dạy, thân thiện với sinh viên.

- Phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng KHCN:

- Tham gia hội đồng phát triển chương trình đào tạo tích hợp ngành Điện tử - Viễn thông (năm 2017).
- Tiếp tục tham gia hội đồng phát triển chương trình đào tạo cho CTĐT hệ thống nhúng thông minh và IoT, ngành Điện tử - Viễn thông (năm 2019).

- Đóng góp khác trong công tác đào tạo:

- Trong thời gian làm trợ lý đào tạo (22/08/2016-01/2019) (i) hỗ trợ Phó Viện trưởng về Đào tạo thực hiện các phiếu khảo sát và phân tích kết quả khảo sát: sinh viên vừa ra trường, đã ra trường lâu hơn 1 năm, doanh nghiệp, giảng viên; (ii) hỗ trợ các công việc rà soát và cải tiến các biểu mẫu thu thập kết quả học nhóm môn học, đánh giá đề án thực tập, tốt nghiệp; (iii) tham gia nhóm viết báo cáo đánh giá chất lượng chương trình đào tạo với AUN: đánh giá chương trình kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) năm 2017.
- Tham gia viết báo cáo đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bởi AUN: 1. đánh giá chương trình ET1 năm 2022; 2. Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh (ET-E5) năm 2023.
- Đảm nhận vai trò Giám đốc chương trình đào tạo Hệ thống nhúng thông minh và IoT: (i) đảm bảo chất lượng dạy và học; (ii) đảm bảo tỉ lệ ra trường và có việc cao; (iii) Liên tục thực hiện điều tra, rà soát và cải tiến chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường công việc.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm 9 tháng

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SDH	
1	2017-2018				8	375		375/819/230
2	2018-2019			1	8	244	12	256/402/230
3	2019-2020				11	207		207/376/230

03 năm học cuối								
4	2020-2021	1			7	105	70	175/312/230
5	2021 - 2022	1			16	267	78	345/553/230
6	2022 - 2023	1			9	400	20	420/570/270

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài :

- Học ĐH ; Tại nước: Pháp; Từ năm 2002 đến năm 2005

- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; Tại nước: Pháp năm 2009

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước :

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài :

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Môn học "Linh kiện điện tử bán dẫn, mã học phần ET2040E" từ năm 2013 đến nay cho chương trình tiên tiến (CTTT) Điện tử - Viễn thông (ET-E4) của Viện Điện tử - Viễn thông, ĐHBKHN Môn học "Điện tử tương tự 1, mã học phần ET3096"; "Điện tử tương tự, mã học phần ET3231E" từ năm 2014 đến nay cho chương trình tiên tiến (CTTT) Kỹ thuật Y sinh (ET -E5) của Viện Điện tử - Viễn thông, ĐHBKHN

d) Đối tượng khác ; Diễn giải:

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			

						dẫn từ ... đến ...		bằng/có quyết định cấp bằng
1	Phạm Thanh Huyền	X				X	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	13/12/2017
2	Nguyễn Văn Hào	X				X	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	08/08/2019
3	Lê Thế Linh		X			X	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	31/05/2013
4	Trịnh Đình Linh		X			X	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	28/01/2013
5	Dương Hoàng Hải		X			X	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách	16/03/2015

							khoa Hà Nội	
6	Nguyễn Công Chức		X	X		08/2013 đến 09/2014	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	03/05/2015
7	Nguyễn Văn Long		X	X		02/2014 đến 09/2014	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	25/05/2016
8	Nguyễn Tiến Thành		X	X		01/2015 đến 03/2016	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	03/07/2017
9	Bùi Văn Diệu		X	X		10/2015 đến 09/2016	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	03/07/2017
10	Nguyễn Văn Quyết		X	X		05/2018 đến 09/2019	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách	30/12/2019

							khoa Hà Nội	
11	Đào Tuấn Minh		X	X		10/2019 đến 03/2021	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	22/06/2022
12	Nguyễn Văn Lâm		X	X		12/2011 đến 09/2013	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	05/08/2014
13	Nguyễn Hữu Chọng		X	X		03/2012 đến 09/2013	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	05/08/2014
14	Phùng Ngọc Sơn		X	X		08/2013 đến 09/2014	Viện Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	06/01/2016

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên

TT	Tên sách	Loại sách (CK, GT, TK, HD)	Nhà xuất bản và năm xuất bản	Số tác giả	Chủ biên	Phân biên soạn (từ trang)	Xác nhận của cơ sở GDDH (Số văn bản xác nhận sử dụng sách)
----	----------	----------------------------	------------------------------	------------	----------	---------------------------	--

						... đến trang)	
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ							
1	Thiết kế IC tương tự	GT	Nhà Xuất Bản Bách Khoa, năm 2023	2	CB		Giấy chứng nhận mục đích sử dụng sách phục vụ đào tạo của ĐHBKHN- 29/06/2023
2	Semiconductor-On- Insulator Materials for Nanoelectronics Applications	TK	Springer, năm 2011	20	VC	(pp. 425- 441)	

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 0 ()

Lưu ý:

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có).

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang.... đến trang..... (ví dụ: 17-56; 145-329).

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm) / Kết quả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Hợp tác chuyển giao công nghệ thiết kế chế tạo vi mạch thu phát năng lượng thấp	CN	36/FIRST/1a/HUST, cấp Nhà nước	17/08/2018 đến 30/06/2019	31/12/2019; Kết quả đánh giá : Hoàn thành (Điểm: 4.72/5)
2	Thiết kế vi mạch quản nguồn năng lượng từ bộ chuyển đổi TEG (Thermal Electric Generator) hiệu	CN	T2018-PC-066, cấp Cơ sở	01/03/2019 đến 31/12/2020	25/12/2020; Kết quả đánh giá và đề tài xếp loại: Tốt

	suất cao sử dụng công nghệ CMOS				
3	Nghiên cứu thiết kế bộ quản lý nguồn năng lượng cho thiết bị bay UAV cho ứng dụng cứu nạn cứu hộ	CN	T2021-PC-014, cấp Cơ sở	01/08/2021 đến 31/07/2022	23/08/2022; Kết quả đánh giá : Xuất sắc

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
1	Process damages in HfO₂/TiN stacks: the key role of H₀ and H₂ anneals	9	Không	IEEE International Electron Devices Meeting/ ISSN: 2156-017X	- Scopus	4	pp. 191-194	04/2006
2	Large-Scale Time Characterization and Analysis of PBTI In HFO₂/Metal Gate Stacks	7	Không	2006 IEEE International Reliability Physics Symposium Proceedings/ISSN: 1938-1891	- Scopus	41	pp. 174-178	03/2006
3	Source-drain Architectures For Advanced Ultra-thin SOI MOSFETs	4	Có	EUROSOI Workshop	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		pp. 63-64	01/2007
4	Mobility issues in double-gate SOI	4	Không	IEEE 37th European Solid State Device	- Scopus	5	pp. 271-274	11/2007

	MOSFETs: Characterization and analysis			Research Conference/ISSN: 2378-6558				
5	Direct comparison of Si/High-K and Si/SiO₂ channels in advanced FD SOI MOSFETs	6	Có	IEEE International SOI Conference/ISSN: 1078-621X	- Scopus	4	pp. 25-26	10/2008
6	FDSOI devices with thin BOX and ground plane integration for 32 nm node and below	28	Không	Solid-State Electronics, ISSN: 0038-1101	Có - SCIE <i>IF: 1,939</i> <i>Scopus Q1 (2009)</i>	150	Volume 53, Issue 7, pp. 730-734	07/2009
7	Electrical Transport characterization of nano CMOS devices with ultra-thin silicon film	17	Không	International Workshop on Junction Technology/ ISBN: 978-1-4244-3319-3	- Scopus	23	pp. 58-63	06/2009
8	Hybrid FDSOI/Bulk high-k/Metal gate platform for Low Power (LP) multimedia technology	44	Không	IEEE International Electron Devices Meeting/ ISSN: 2156-017X	- Scopus	58	pp. 667-670	12/2009
9	In Situ Comparison of Si/High-κ and Si/SiO₂ Channel Properties in SOI MOSFETs	6	Có	IEEE Electron Device Letters/ISSN: 1558-0563	Có - SCIE <i>IF: 3,249</i> <i>WoS Q1 (2009)</i>	34	Vol. 30, No. 10, pp. 1075-1077	09/2009
10	Back-Gate Influence on the Mobility Behavior	5	Không	ECS Transactions/ISSN: 19385862	Có - SCIE <i>IF: 0,635</i>		Vol. 23, No. 1, pp. 583-589	09/2009

	in Ultrathin FD SOI Devices				Scopus Q2 (2009)			
11	Ultra Compact FDSOI Transistors including Strain and Orientation: Processing and Performance	15	Không	ECS Transactions/ ISSN: 19385862	Có - SCIE IF: 0,635 Scopus Q2 (2009)	5	Vol. 19, No. 4, pp. 55-64	05/2009
12	Impact of TiN gate thickness in advanced FD SOI MOSFETs	5	Có	2009 Silicon Nanoelectronics Workshop, ISSN: 1078-621X	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		pp. 129-130	06/2009
13	Mobility enhancement by CESL strain in short-channel ultrathin SOI MOSFETs	5	Có	Solid-State Electronics/ ISSN: 0038-1101	Có - SCIE IF: IF = 1,955 WoS Q1 (2010)	22	Volume 54, Issue 2, pp. 123-130	02/2010
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ								
14	Impact of a 10nm Ultra-Thin BOX (UTBOX) and Ground Plane on FDSOI devices for 32nm node and below	32	Không	Solid State Electronics/ ISSN: 1930-8833	Có - ESCI IF: IF = 1,955 WoS Q1 (2010)	56	Volume 54, Issue 9 pp. 849-854	09/2010
15	Advanced Solutions for Mobility Enhancement in SOI MOSFETs	16	Có	International Journal of High Speed Electronics and Systems/ ISSN: 1291564	Có - SCIE IF: IF = 0,652 WoS Q3 (2011)		Vol. 20, No. 1, pp. 81-93	07/2011
16	Design of Integrated	5	Không	2013 International Conference on Advanced	- Scopus		pp. 693-696	10/2013

	LEO/GPS Antenna			Technologies for Communications/ ISSN: 2162-1039				
17	Compact metamaterial CPW-fed WLAN antenna	6	Không	2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications/ ISSN: 2162-1039	- Scopus	1	pp. 457-460	10/2013
18	A High Power Conversion Efficiency Rectifier with New Internal VTh Cancellation Topology for RFID Applications	6	Có	2014 IEEE Fifth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)/ ISBN: 978-1-4799-5051-5	- Scopus	7	pp. 313-316	07/2014
19	A Fast and Long-Life Li-Ion Battery Charger With Decoupled Current-Source	5	Không	The 2014 International Conference on Integrated Circuits/ ISBN: 978-4-88552-294-9	- Hệ thống CSDL quốc tế khác		pp. 123-128	10/2014
20	A Li-Ion battery charger with stable charging mode controller in noise environments	5	Không	2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications, ISSN: 2162-1020	- Scopus	1	pp. 270-274	10/2015
21	Li-ion battery charger circuit for biomedical devices	6	Có	2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications/ ISSN: 2162-1020	- Scopus	2	pp. 362-365	10/2015

22	An Ultra-Small Capacitor-less LDO with Controlled resistance Technique and MOSFET-only Bandga	3	Có	2015 International Conference on Advanced Technologies for Communications/ ISSN: 2162-1020	- Scopus	3	pp. 372-377	10/2015
23	Low-power organic comparator with complementary technology	4	Không	Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng/ ISSN: 1859-1531			Quyển 2, Số 11(96).2015	12/2015
24	A Topology of Charging Mode Control Circuit Suitable for Long-Life Li-Ion Battery Charger	5	Không	2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics/ ISBN: 978-1-5090-1801-7	- Scopus	8	pp. 167-171	07/2016
25	Design and Simulation of a 6-Bit Successive-Approximation ADC Using Modeled Organic Thin-Film Transistors	5	Không	Hindawi Publishing Corporation; Active and Passive Electronics Components/ ISSN: 8827516	Có - ESCI <i>IF: IF = 1,333 (WoS)</i>	6	Volume 2016	03/2016
26	Dynamic Error Correction Technique for Wide-band 0.4 – 4 GHz Direct Receiver	7	Không	2017 2nd Workshop on Recent Trends in Telecommunications Research/ ISBN: 978-1-5090-5541-8	- Scopus		pp. 1-4	02/2017
27	An ultra-low-voltage-startup	3	Có	2017 7th International	- Scopus	3	pp. 28-32	10/2017

	circuit for thermal energy harvesting application			Conference on Integrated Circuits/ ISBN: 978-1-5386-3377-9				
28	An adaptive DC-DC converter for loading circuit of Li-Ion battery charger	3	Có	2017 7th International Conference on Integrated Circuits, Design, and Verification/ ISBN: 978-1-5386-3377-9	- Scopus	3	pp. 100-103	10/2017
29	Clock Generator for Wide-band Delta-Sigma ADCs	6	Có	Journal of Science and Technology, Technical Universities/ ISSN: 2354-1083			No. 120C, pp. 104-108	12/2017
30	A 14-W 94%-Efficient Hybrid DC-DC Converter with Advanced Bootstrap Gate Drivers for Smart Home LED Applications	6	Có	2018 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition/ ISSN: 2329-3748	- Scopus	2	pp. 4744-4749	11/2018
31	An Adaptive and Wide-Range Output DC-DC Converter for Loading Circuit of Li-Ion Battery Charger	3	Có	VNU Journal of Science: Computer Science & Communication Engineering/ ISSN: 2588-1086		1	Vol. 34, 1(2018), pp. 10-18	07/2018
32	LQG Regulator for Control Moment Gyroscope based Balancing System	4	Không	2018 IEEE Seventh International Conference on Communications and Electronics/	- Scopus	2	pp. 202-207	07/2018

				ISBN: 978-1-5386-3679-4				
33	A Loop Control Design to Achieve Boundary Conduction Mode in DC-DC Power Converter for Maximizing Efficiency	5	Có	2019 13th International Conference on Sensing Technology (ICST)/ ISSN: 2156-8073	- Scopus		pp. 1-6	12/2019
34	Three-Phase Boost-Converter Based PMIC for Thermal Electric Generator	5	Có	2019 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS)/ ISBN: 978-1-7281-2940-2	- Scopus	1	pp. 205-208	11/2019
35	A 5th-order Configurable-Frequency Direct Delta-Sigma Converter for Mobile Application	7	Có	2019 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)/ ISSN: 2162-1039	- Scopus		pp. 292-296	10/2019
36	ElectroMyography Acquisition System Using Graphene-based e-Textiles	6	Có	2019 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering (ISEE)/ ISBN: 978-1-7281-5353-7	- Scopus	8	pp. 59-62	10/2019
37	A fully CMOS circuit design for an autonomous continuous chaotic system	4	Không	2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics			pp. 608-611	01/2021

				(Poster)/ ISBN: 978-1-7281-5469-5				
38	A Low Power Circuit Design For Chaos-Key Based Data Encryption	4	Không	IEEE Access/ ISSN: 2169-3536	Có - SCIE <i>IF: IF = 4,276 WoS Q1 (2020)</i>	17	Vol. 8 pp. 104432-104444	05/2020
39	Power Management IC With a Three-Phase Cold Self-Start for Thermoelectric Generators	5	Có	IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers/ ISSN: 1549-8328	Có - SCIE <i>IF: IF = 4,223 WoS Q1 (2020)</i>	6	Vol. 68, No. 1, pp. 103-113	09/2020
40	Low-Power PMIC with Two Hybrid Converters for TEG Application	7	Không	2020 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS)/ ISBN: 978-1-7281-9396-0	- Scopus	1	pp. 15-18	12/2020
41	Wireless Wearable ElectroMyography Acquisition System Utilizing Reduced-Graphene-Oxide Based Sensor	5	Có	2021 8th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science/ ISBN: 978-1-6654-1001-4	- Scopus	1	pp. 302-306	11/2021
42	1.2 μW 41dB Ripple Attenuation Chopper Instrumentation Amplifier Using Auto-zero Offset Cancellation Loop	5	Không	2021 International Conference on Advanced Technologies for Communications/ ISSN: 2162-1039	- Scopus		pp. 167-171	10/2021

43	An 86.7%-Efficient Three-Level Boost Converter with Active Voltage Balancing for Thermoelectric Energy Harvesting	7	Có	2022 IEEE Custom Integrated Circuits Conference/ ISSN: 2152-3630	- Scopus	1	pp. 1-2	04/2022
44	A 1.2-μW 41-dB Ripple Attenuation Chopper Amplifier Using Auto-Zero Offset Cancellation Loop for Area-Efficient Biopotential Sensing	4	Có	2022 Electronics, MDPI/ ISSN: 20799292	Có - SCIE <i>IF: IF = 3,271</i> <i>Scopus Q2 (2022)</i>	1	Vol. 11, Issue 7, pp. 1-12	06/2022
45	A Configurable Direct Delta-Sigma Converter for Frequency Division Duplex (FDD) Bands from 0.4 GHz to 3.6 GHz	3	Có	Journal of Science and Technology: Smart Systems and Devices/ ISSN: 2734-9373			Vol. 32, Issue 1, pp. 67-75	01/2022
46	Calibration of gain and timing mismatch for TI-ADCs with signals in all Nyquist zones using adaptive noise canceller	5	Không	Journal of Military Science and Technology/ ISSN: 1859-1043			pp. 137-149	02/2022
47	Integrated Modified Three-	5	Có	2022 IEEE Ninth International	- Scopus		pp. 450-454	07/2022

	Level Buck Converter with Flying Capacitor-Voltage Self-Balance			Conference on Communications and Electronics (ICCE)/ ISBN: 978-1-6654-9745-9				
48	A 0.47-μW Multi-Stage Low Noise Amplifier Employing 0.2-V-Supply OTA	5	Có	2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)/ ISBN: 978-1-6654-9745-9	- Scopus		pp. 190-194	07/2022
49	A 5.8-μW 61.29-dB-SNDR 10-Bits Configurable EEG Acquisition System	5	Có	2022 IEEE Ninth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)/ ISBN: 978-1-6654-9745-9	- Scopus		pp. 199-203	07/2022
50	Efficient GaN-based hybrid DC-DC converter with simple and low-cost bootstrap gate drivers for LED lighting applications	4	Có	AEU - International Journal of Electronics and Communications/ ISSN: 1434-8411	Có - SCIE <i>IF: IF = 3,877</i> <i>Scopus Q2 (2022)</i>		Vol. 155	08/2022
51	A 60V Input Integrated 3-to-1 Dual Inductor Hybrid Dickson Converter	4	Có	2022 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS)/ ISBN: 978-1-6654-5073-7	- Scopus		pp. 309-313	11/2022
52	Performance Analysis and Experiment of	6	Không	2022 11th International Conference on	- Scopus		pp. 552-557	11/2022

Data Transmission Rate of LEDs in Optical Camera Communication for Indoor Positioning System			Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS)/ ISSN: 2475-7896				
--	--	--	---	--	--	--	--

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 4 ([15] [39] [44] [50])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (*Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg*)

TT	Tên bài báo/báo cáo KH	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Thuộc danh mục tạp chí uy tín của ngành	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
Không có							

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành mà UV là tác giả chính sau PGS/TS: 0

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/ đồng tác giả	Số tác giả
Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ					
1	Hệ thống đo đạc và phân tích tín hiệu điện cơ có sử dụng cảm biến được làm từ vật liệu graphen	Cục sở hữu trí tuệ	30/05/2023	Đồng tác giả	4

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: 1

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT	Tên tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu TDTT	Cơ quan/tổ chức công nhận	Văn bản công nhận (số, ngày, tháng, năm)	Giải thưởng cấp Quốc gia/Quốc tế	Số tác giả
Không có					

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi Chú
1	Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Mã ngành: ET1)	Tham gia	Số 920/QĐ-ĐHBK-TCCB, ngày 05/05/2017	Phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội	Quyết định Ban hành bộ chương trình đào tạo Cử nhân 2017, Số 05A/QĐ-ĐHBK-ĐT; ký ngày 28/02/2019	Vai trò thư ký
2	Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông cho Chương trình tiên tiến Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Mã ngành: ET-E9)	Tham gia	Số 90B/QĐ-ĐHBK-ĐT, ngày 28/01/2019	Phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội	Quyết định Ban hành và triển khai đào tạo CTĐT tiên tiến "Hệ thống nhúng thông minh và IOT"; số 170A/QĐ-ĐHBK-ĐT, ký ngày 19/08/2019	Vai trò thư ký

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu:

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS)

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)